

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника

Наименование образовательной программы: Микроэлектроника и твердотельная электроника

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

Блок:	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Часть образовательной программы:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
№ дисциплины по учебному плану:	Б1.Ч.01.13
Трудоемкость в зачетных единицах:	8 семестр - 6;
Часов (всего) по учебному плану:	216 часов
Лекции	не предусмотрено учебным планом
Практические занятия	8 семестр - 56 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	8 семестр - 14 часов;
Самостоятельная работа	8 семестр - 141,4 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	8 семестр - 4 часа;
включая:	
Контрольная работа	
Промежуточная аттестация:	
Защита курсовой работы	8 семестр - 0,3 часа;
Зачет с оценкой	8 семестр - 0,3 часа;
	всего - 0,6 часа

Москва 2019

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

(должность)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Зезин Д.А.
	Идентификатор	Re7522a00-ZezinDA-ba8dbd73

(подпись)

Д.А. Зезин

(расшифровка
подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

(должность, ученая степень, ученое
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Баринов А.Д.
	Идентификатор	Ra98e1318-BarinovAD-f138ec4f

(подпись)

А.Д. Баринов

(расшифровка подписи)

Заведующий
выпускающей кафедры

(должность, ученая степень, ученое
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Мирошникова И.Н.
	Идентификатор	Rd1db27a5-MiroshnikovaIN-70caf8c

(подпись)

И.Н.

Мирошникова

(расшифровка подписи)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: Углублённое изучение физических основ и разновидностей полупроводниковых приборов и компонентов интегральных схем, их принципа действия, основных параметров и характеристик, области применения

Задачи дисциплины

- развитие способности учитывать физические основы работы полупроводниковых приборов и интегральных схем, применяемых в приборах и устройствах электроники и нанoeлектроники, современные тенденции развития электроники;;
- освоение способности строить простейшие физические и математические модели полупроводниковых приборов и интегральных схем, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования;;
- развитие способности аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов и интегральных схем;;
- развитие готовности анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчётов..

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ПК-1 Способен участвовать в проектировании полупроводниковых приборов	ИД-1 _{ПК-1} Демонстрирует знание принципов работы, физических и математических моделей основных полупроводниковых приборов	знать: - методы оптимизации параметров полупроводниковых полевых транзисторов. уметь: - оптимизировать конструкцию полевых транзисторов для достижения требуемых параметров.
ПК-2 Способен участвовать в проектировании интегральных схем	ИД-1 _{ПК-2} Использует средства автоматизации схемотехнического проектирования	знать: - методы оптимизации параметров полупроводниковых интегральных схем. уметь: - экстрагировать параметры моделей из эксперимента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Микроэлектроника и твердотельная электроника (далее – ОПОП), направления подготовки 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Базируется на уровне среднего общего образования.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										Содержание самостоятельной работы/ методические указания
				Контактная работа							СР			
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль	
КПР	ГК	ИККП	ТК											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры	38	8	-	-	12	-	-	-	-	-	26	-	<u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> [1], с. 133-190, 410-428 <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [2], с. 133-190, 410-428
1.1	Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры	38		-	-	12	-	-	-	-	-	26	-	
2	Модели полевых элементов ИС	41.4		-	-	12	-	-	-	-	-	29.4	-	<u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> [1], с. 301-367 [2], с. 2-26 <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [2], с. 301-367 [3], с. 2-26 [4], с. 2-26
2.1	Модели полевых элементов ИС	41.4		-	-	12	-	-	-	-	-	29.4	-	
3	Модели короткоканальных полевых ИС	42		-	-	12	-	-	-	-	-	30	-	<u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> [1], с. 301-367 <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], с. 25–36, 223–233 [2], с. 191-249
3.1	Модели короткоканальных полевых ИС	42		-	-	12	-	-	-	-	-	30	-	
4	Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов. Особенности	42		-	-	12	-	-	-	-	-	30	-	<u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> [1], с. 191-249 [3], с. 25–36, 223–233 <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [2], с. 301-367

	функционально ориентированных ИС												
4.1	Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов. Особенности функционально ориентированных ИС	42	-	-	12	-	-	-	-	-	30	-	
5	Перспективные транзисторы	34	-	-	8	-	-	-	-	-	26	-	<i>Подготовка к аудиторным занятиям: [3], с. 25–36, 223–233</i>
5.1	Перспективные транзисторы	34	-	-	8	-	-	-	-	-	26	-	
	Зачет с оценкой	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	
	Курсовая работа (КР)	18.3	-	-	-	14	-	4	-	0.3	-	-	
	Всего за семестр	216.0	-	-	56	14	-	4	-	0.6	141.4	-	
	Итого за семестр	216.0	-	-	56	14		4		0.6	141.4		

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПр – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

3.2 Краткое содержание разделов

1. Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры

1.1. Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры

Классификация интегральных схем по элементной базе, полупроводниковому материалу, технологии и схемо-топологическим решениям. Основные базовые элементы и компоненты полупроводниковых интегральных схем. Общие положения математической формулировки задач моделирования физических процессов в элементах интегральных схем. Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры. Кинетическое уравнение Больцмана, основные приближения и допущения в моделях элементов ИС. Представление о физико-топологическом и схмотехническом уровнях моделирования ИС..

2. Модели полевых элементов ИС

2.1. Модели полевых элементов ИС

ИС на основе полевых транзисторов с управляющим р-n переходом. Модель полевого транзистора с произвольным профилем легирования канала. Элементы ИС с МОП - структурой. Полевые транзисторы для МОП ИС. Модель МДП транзистора. Подпороговые характеристики МДП транзисторов. Эффекты сильного поля в канале МДП транзисторов..

3. Модели короткоканальных полевых ИС

3.1. Модели короткоканальных полевых ИС

МОС-структура с протяженными областями. Короткоканальные полевые транзисторы для МОП ИС. Подпороговые характеристики короткоканальных МДП транзисторов. Короткоканальные эффекты в МДП транзисторах. Подпороговые токи, эффект модуляции барьера истока стоковым напряжением, изменение порогового напряжения. Умножение носителей и зарядка окисла в МДП транзисторах. Инжекционный пробой. Эффект «защёлки» (тиристорный эффект) в КМОП ИС, методы его подавления. Масштабная миниатюризация в МДП ИС и её пределы. Эффекты горячих носителей в короткоканальных МДП приборах и методы подавления этих эффектов. Баллистический режим..

4. Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов. Особенности функционально ориентированных ИС

4.1. Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов. Особенности функционально ориентированных ИС

Биполярные интегральные схемы на основе гетеропереходов. Особенности ИС на основе GaAs. Барьер Шоттки. Инжекция неосновных носителей. Полевые транзисторы с гетеропереходами. Основные типы конструкций. Нелинейные резисторы в ИС на основе GaAs. Особенности полевых транзисторов на основе широкозонных полупроводников (GaAs, SiC, AlGaN) по сравнению с транзисторами на основе кремния (Si)..

5. Перспективные транзисторы

5.1. Перспективные транзисторы

Модель двух областей, модель с полностью насыщенной скоростью. Полевые транзисторы с высокой подвижностью электронов Приборы с зарядовой связью, физические

основы работы. Основные характеристики, верхняя и нижняя рабочие частоты, эффективность переноса. Физика элементов статической памяти на основе структур металл-диэлектрик-(диэлектрик)-полупроводник. Элементы памяти с лавинной инжекцией заряда. Элементы памяти с двухслойным диэлектриком. Проблемы элементной базы аналоговых ИС, интегральных схем ЦАП-АЦП. Методы экспериментального исследования элементов ИС на стадии разработки и производства. Принципы и приёмы разработки тестовых структур элементов, узлов и микросистем. Представления об автоматизированных системах экспериментальных исследований элементов тестовых структур..

3.3. Темы практических занятий

1. Принципы и приёмы разработки тестовых структур элементов, узлов и микросистем. Представления об автоматизированных системах экспериментальных исследований элементов тестовых структур;
2. Эффекты горячих носителей в короткоканальных МДП приборах и методы подавления этих эффектов.;
3. Проблемы элементной базы аналоговых ИС, интегральных схем ЦАП-АЦП.;
4. Элементы памяти с двухслойным диэлектриком.;
5. Элементы памяти с лавинной инжекцией заряда.;
6. Физика элементов статической памяти на основе структур металл-диэлектрик-(диэлектрик)-полупроводник.;
7. Основные характеристики, верхняя и нижняя рабочие частоты, эффективность переноса.;
8. Приборы с зарядовой связью, физические основы работы.;
9. Полевые транзисторы с высокой подвижностью электронов;
10. Модель двух областей, модель с полностью насыщенной скоростью.;
11. Особенности полевых транзисторов на основе широкозонных полупроводников (GaAs, SiC, AlGaN) по сравнению с транзисторами на основе кремния (Si).;
12. Нелинейные резисторы в ИС на основе GaAs.;
13. Основные типы конструкций.;
14. Полевые транзисторы с гетеропереходами.;
15. Инжекция неосновных носителей.;
16. Особенности ИС на основе GaAs. Барьер Шоттки.;
17. Методы экспериментального исследования элементов ИС на стадии разработки и производства.;
18. Баллистический режим. Биполярные интегральные схемы на основе гетеропереходов.;
19. Масштабная миниатюризация в МДП ИС и её пределы.;
20. Основные базовые элементы и компоненты полупроводниковых интегральных схем.;
21. Инжекционный пробой. Эффект «защёлки» (тиристорный эффект) в КМОП ИС, методы его подавления.;
22. Подпороговые токи, эффект модуляции барьера истока стоковым напряжением, изменение порогового напряжения.;
23. Короткоканальные эффекты в МДП транзисторах.;
24. Подпороговые характеристики короткоканальных МДП транзисторов.;
25. Короткоканальные полевые транзисторы для МОП ИС.;
26. МОС-структура с протяженными областями.;
27. Эффекты сильного поля в канале МДП транзисторов.;
28. Подпороговые характеристики МДП транзисторов.;
29. Элементы ИС с МОП - структурой. Полевые транзисторы для МОП ИС. Модель МДП транзистора.;
30. Модель полевого транзистора с произвольным профилем легирования канала.;

31. ИС на основе полевых транзисторов с управляющим р-п переходом. .;
32. Представление о физико-топологическом и схемотехническом уровнях моделирования ИС.;
33. Кинетическое уравнение Больцмана, основные приближения и допущения в моделях элементов ИС.;
34. Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры.;
35. Общие положения математической формулировки задач моделирования физических процессов в элементах интегральных схем.;
36. Умножение носителей и зарядка окисла в МДП транзисторах.;
37. Классификация интегральных схем по элементной базе, полупроводниковому материалу, технологии и схемо-топологическим решениям..

3.4. Темы лабораторных работ не предусмотрено

3.5 Консультации

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ 8 Семестр

Курсовая работа (КР)

График выполнения курсового проекта

Неделя	1 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	Зачетная
Раздел курсового проекта	1	2	3	4	Защита курсового проекта
Объем раздела, %	10	20	20	50	-
Выполненный объем нарастающим итогом, %	10	30	50	100	-

Номер раздела	Раздел курсового проекта
1	1
2	2
3	3
4	4

3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)					Оценочное средство (тип и наименование)
		1	2	3	4	5	
Знать:							
методы оптимизации параметров полупроводниковых полевых транзисторов	ИД-1ПК-1	+					Контрольная работа/КМ-1
методы оптимизации параметров полупроводниковых интегральных схем	ИД-1ПК-2		+				Контрольная работа/КМ-2
Уметь:							
оптимизировать конструкцию полевых транзисторов для достижения требуемых параметров	ИД-1ПК-1			+			Контрольная работа/КМ-3
экстрагировать параметры моделей из эксперимента	ИД-1ПК-2				+	+	Контрольная работа/КМ-4

4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

4.1. Текущий контроль успеваемости

8 семестр

Форма реализации: Защита задания

1. КМ-4 (Контрольная работа)

Форма реализации: Проверка задания

1. КМ-1 (Контрольная работа)
2. КМ-2 (Контрольная работа)
3. КМ-3 (Контрольная работа)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

Балльно-рейтинговая структура курсовой работы является приложением Б.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Зачет с оценкой (Семестр №8)

Оценка выставляется по результатам текущего контроля в соответствии с БАРС

Курсовая работа (КР) (Семестр №8)

В диплом выставляется оценка за 8 семестр.

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Печатные и электронные издания:

1. Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учебное пособие для вузов по направлению 210100 "Электроника и микроэлектроника" / В. И. Старосельский . – М. : Юрайт, 2014 . – 463 с. – (Основы наук) . - ISBN 978-5-9916-0808-4 . ;
2. Твердотельная электроника : учебное пособие для вузов по направлению "Электроника и микроэлектроника" / Э. Н. Воронков, [и др.] . – М. : АКАДЕМИЯ, 2009 . – 320 с. – (Высшее профессиональное образование) . - ISBN 978-5-7695-4618-1 . ;
3. Шалимова, К. В. Физика полупроводников : учебник / К. В. Шалимова . – 4-е изд., стер . – М. : Лань-Пресс, 2010 . – 400 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . - ISBN 978-5-8114-0922-8 . ;
4. Шалимова К. В.- "Физика полупроводников", (4-е изд., стер.), Издательство: "Лань", Санкт-Петербург, 2010 - (384 с.)
https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=648.

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Office / Российский пакет офисных программ;
2. ОС Linux.

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
	отсутствует	

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование элементов интегральных схем

(название дисциплины)

8 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

КМ-1 КМ-1 (Контрольная работа)

КМ-2 КМ-2 (Контрольная работа)

КМ-3 КМ-3 (Контрольная работа)

КМ-4 КМ-4 (Контрольная работа)

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
		Неделя КМ:	1	8	12	16
1	Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры					
1.1	Фундаментальные уравнения физических процессов в объёме полупроводниковой структуры		+			
2	Модели полевых элементов ИС					
2.1	Модели полевых элементов ИС			+		
3	Модели короткоканальных полевых ИС					
3.1	Модели короткоканальных полевых ИС				+	
4	Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов. Особенности функционально ориентированных ИС					
4.1	Транзисторы на основе широкозонных полупроводников и гетеропереходов. Особенности функционально ориентированных ИС					+
5	Перспективные транзисторы					
5.1	Перспективные транзисторы					+
Вес КМ, %:			10	20	20	50

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА/РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проектирование элементов интегральных схем

(название дисциплины)

8 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по курсовой работе:

КМ-1 1
КМ-2 2
КМ-3 3
КМ-4 4

Вид промежуточной аттестации – защита КР.

Номер раздела	Раздел курсового проекта/курсовой работы	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
		Неделя КМ:	4	8	12	16
1	1		+			
2	2			+		
3	3				+	
4	4					+
Вес КМ, %:			10	20	20	50